

2SC1327, 2SC1328

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ型 / Si NPN Epitaxial Planar

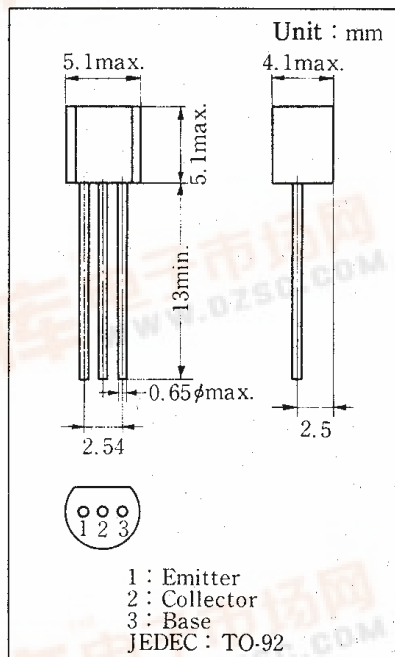
低周波低雑音前置増幅用 / AF Low Noise Pre-Amplifier

特 徴 / Features

- 雑音電圧 NV が低い。 / Low noise voltage
- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きい。 / High h_{FE}
- PNP 型の 2SA721, 2SA722 もあります。 / PNP types (2SA721, 2SA722) are available

最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SC1327	35	V
	2SC1328	55	
コレクタ・エミッタ電圧	2SC1327	35	V
	2SC1328	55	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CM}	100	mA
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	150	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$



電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	35			V
			55			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=1\text{mA}, I_B=0$	35			V
			55			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5			V
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0$		1	100	nA
	I_{CEO}	$V_{CE}=10\text{V}, I_B=0$		0.01	1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CB}=5\text{V}, -I_E=2\text{mA}$	180		1040	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}^{**}$			0.6	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=100\text{mA}^{**}$		0.7	1	V
雑音電圧	NV	$V_G=80\text{dB}, V_{CE}=10\text{V}, I_C=1\text{mA}, R_g=100\text{k}\Omega, \text{Function}=\text{FLAT}$			150	mV
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=5\text{V}, -I_E=10\text{mA}$		250		MHz

** パルス測定 / Pulse Test

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

h_{FE} 分類	R	S	T	U
h_{FE} 範囲	130~360	260~520	360~700	520~1040

